(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-236781

(43)公開日 平成9年(1997)9月9日

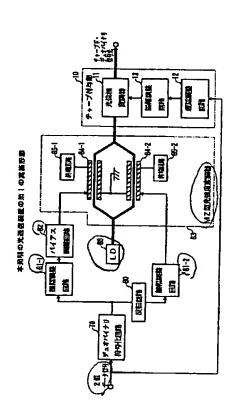
(51) Int. Cl. 6		織別記号	庁内整理番号	FI 技術表示箇所					
G 0 2 F	1/01			G02F	1/01		В	Z m z ·	, , 10, 12, 1
	1/35	501			1/35	501	_		
H 0 4 B	10/152			H 0 4 B	9/00		L		
	10/142						Y		
	10/04								
	審査請	求 未請求 ————	請求項の数10	OL			(全14頁	〔〕最終頁に	に続く
(21)出顧番号	特願平8-41966			(71)出額人	000004226				
					日本電信電話株式会社				
(22) 出願日	平成8	年(1996)2月	28日				新宿三丁目	19番2号	
				(72)発明者	米永	一茂			
					東京都	新宿区西	新宿三丁目	19番2号	日本
					電信電	話株式会	社内		
				(72)発明者	桑野	茂			
					東京都	新宿区西	新宿三丁目	19番2号	日本
					電信電	話株式会	社内		
				(72)発明者	髙知尾	昇			
					東京都	新宿区西	新宿三丁目	19番2号	日本
					電信電	話株式会	社内		
				(74)代理人	弁理士	古谷	史旺		

(54) 【発明の名称】光送信装置およびそれを用いた光伝送システム

(57)【要約】

【課題】 光ファイバに大きな信号パワーを入射しても 劣化が少ない変調信号光を生成する。

【解決手段】 2値データ信号をデュオバイナリ信号に変換し、このデュオバイナリ信号の振幅の中央値に対する変調信号光の強度が最小であり、デュオバイナリ信号の他の2値に対する変調信号光の強度が最大でかつ変調信号光の位相が互いに反転し、さらに変調信号光の位相をその強度に応じて連続的に変化させる光変調手段を用いる。光変調手段は、符号変換手段と、変調器駆動信号生成手段と、マッハツェンダ干渉計型光強度変調器と、光位相変調手段を用いて構成され、デュオバイナリ信号により変調された変調信号光(デュオバイナリ信号光)の位相をその強度に応じて変化させる。



1) 4) 1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光搬送波を出力する光源と、

2値データ信号を入力し、この2値データ信号に応じて 前記光搬送波を変調した変調信号光を出力する光変調手 段とを備えた光送信装置において、

前記光変調手段は、前記 2 値データ信号をデュオバイナリ信号に変換し、このデュオバイナリ信号の振幅の中央値に対する変調信号光の強度が最小であり、デュオバイナリ信号の他の 2 値に対する変調信号光の強度が最大でかつ変調信号光の位相が互いに反転し、さらに変調信号 10 光の位相をその強度に応じて連続的に変化させる構成であることを備えたことを特徴とする光送信装置。

【請求項2】 光変調手段は、

2値データ信号をデュオバイナリ信号に変換する符号変 換手段と、

前記デュオバイナリ信号から振幅が等しく位相が反転した一対の変調器駆動信号を生成する変調器駆動信号生成 手段と、

前記一対の変調器駆動信号を入力し、2つに分岐された 光搬送波の位相をそれぞれ変化させて光強度変調した変 20 調信号光を出力するマッハツェンダ干渉計型光強度変調 器と、

前記2値データ信号を入力し、前記光搬送波または前記 変調信号光の位相をその2値データ信号に応じて変化さ せる光位相変調手段とを備えたことを特徴とする請求項 1に記載の光送信装置。

【請求項3】 光変調手段は、

2値データ信号をデュオバイナリ信号に変換する符号変 換手段と、

前記デュオバイナリ信号から振幅が等しく位相が反転し 30 た一対の変調器駆動信号を生成する変調器駆動信号生成 手段と、

前記一対の変調器駆動信号を入力し、2つに分岐された 光撤送波の位相をそれぞれ変化させて光強度変調した変 調信号光を出力するマッハツェンダ干渉計型光強度変調 器と、

前記変調信号光の一部を分岐してその光強度を検出し、 その光強度に応じて前記変調信号光の位相を変化させる 光位相変調手段とを備えたことを特徴とする請求項1に 記載の光送信装置。

【請求項4】 光変調手段は、

2 値データ信号をデュオバイナリ信号に変換する符号変 換手段と、

前記デュオバイナリ信号から振幅が等しく位相が反転した一対の変調器駆動信号を生成する変調器駆動信号生成 手段と、

前記一対の変調器駆動信号を入力し、2つに分岐された 光搬送波の位相をそれぞれ変化させて光強度変調した変 調信号光を出力するマッハツェンダ干渉計型光強度変調 器と、 前記一対の変調器駆動信号の中央値だけをシフトさせ、 その中央値に対して前記変調信号光の強度が最小となり、他の2値に対して前記変調信号光の強度が最大となる。 対の変調器 関係 日本教育 オスメクログ

るように前記一対の変調器駆動信号を設定する光位相変 調手段とを備えたことを特徴とする請求項1に記載の光 送信装置。

【請求項5】 光位相変調手段は、

2値データ信号を入力し、その振幅を調整する手段と、 前記振幅が調整された2値データ信号を一対の変調器駆動信号にそれぞれ加算する手段とを備えたことを特徴と する請求項4に記載の光送信装置。

【請求項6】 変調変調器駆動信号生成手段および光位 相変調手段は、

2値データ信号を入力し、その振幅を調整する手段と、 符号変換手段から出力されるデュオバイナリ信号と、前 記振幅が調整された2値データ信号とを加算および減算 し、振幅が等しく位相が反転しかつ中央値がシフトした 一対の変調器駆動信号を生成する手段とを備えたことを 特徴とする請求項4に記載の光送信装置。

20 【請求項7】 光変調手段は、

2値データ信号をデュオバイナリ信号に変換する符号変 換手段と、

前記2値データ信号から振幅が異なり位相が反転した一 対の変調器駆動信号を生成する変調器駆動信号生成手段 と

前記一対の変調器駆動信号を入力し、2つに分岐された 光撤送波の位相をそれぞれ変化させて光強度変調し、か つ変調信号光に対してその強度に応じた位相変化を与え るマッハツェンダ干渉計型光強度変調器と、

前記デュオバイナリ信号を入力し、その最大値と最小値 に対して前記光搬送波または前記変調信号光の位相を反 転させる光位相変調手段とを備えたことを特徴とする請 求項1に記載の光送信装置。

【請求項8】 光鍛送波の波長値が、変調信号光が送出される光ファイバの零分散波長値より大きいことを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載の光送信装置。

【請求項9】 請求項1~8のいずれかに記載の光送信装置と、

前記光送信装置から出力された変調信号光を受信し復調 40 する光受信装置と、

前記光送信装置と前記光受信装置とを結合する光伝送路 とを備えたことを特徴とする光伝送システム。

【請求項10】 光受信装置は、光直接検波を行う構成であることを特徴とする請求項9に記載の光伝送システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、伝送距離の長距離 化、伝送速度の高速化に対応する光送信装置およびそれ 50 を用いた光伝送システムに関する。

2

[0002]

【従来の技術】光伝送システムでは、強度変調-直接検 波方式(以下「IM-DD方式」という。) が最も簡易 な伝送方式である。波長分散が大きい光ファイバ(既設 の1.3μm零分散ファイバ)を伝送路として用いる光伝 送系では、伝送距離や伝送速度が波長分散によって大き く制限される。この波長分散による信号劣化は信号のス ペクトル広がりに依存している。そこで、半導体レーザ の直接変調の代わりに、マッハツェンダ干渉計型(以下 「MZ型」という。) の光強度変調器を外部変調器とし 10 て用いることにより、信号スペクトルの過剰な広がりを 抑圧でき伝送距離を延ばすことができる。なお、MZ型 光強度変調器は、LiNbO₃ や半導体を用いて作製され る。しかし、10Gb/s 以上の高速光伝送では、光信号自 体のスペクトル広がりのために、MZ型光強度変調器を 用いたとしても波長分散により伝送距離が数十km程度 に制限される。

【0003】この波長分散による限界を克服する手段と して、デュオバイナリ信号光を用いた光伝送方式が提案 されている (K. Yonenaga et al., Electron. Lett., vo 1.31, pp. 302-304, 1995)。図11は、従来の光デュオバ イナリ伝送システムの構成例を示す。図において、伝送 すべき2値データ信号は、デュオバイナリ符号化回路7 〇で3値のデュオバイナリ信号に変換される。このデュ オバイナリ信号は2分岐され、その一方の経路に挿入さ れた反転回路80により反転信号と非反転信号になり、 振幅調整回路81一1,81-2およびバイアス調整回 路82を介して、それぞれM乙型光強度変調器83の電 極84-1,84-2に印加される。電極84-1,8 4-2の他端には終端回路85-1,85-2が接続さ れる。

【0004】半<u>導体レーザ(LD)86の出力光は、こ</u> の<u>互いに位相が反転した2つの</u>デュオバイナリ<u>信号</u>に応 じて強度変調され、その変調信号光が光ファイバ伝送路 87に送出される。このとき、デュオバイナリ信号の3 つの信号点を、図12に示すようにM2型光強度変調器 の隣接する最大透過率の点A、最小透過率の点B、最大 透過率の点Cに対応させて変調し、デュオバイナリ信号 光を生成する。なお、点Aと点Cではともに変調信号光 の強度が最大となるが、位相が反転する。

【0005】光ファイバ伝送路87から出力された変調 信号光は光検波回路88で直接検波され、その検波信号 を臨別器89で識別し、反転回路90で論理反転するこ とにより2値データ信号が復調される。デュオバイナリ 符号は帯域圧縮符号の一種であり、その占有帯域は通常 の2値信号の約半分に圧縮される。従って、デュオバイ ナリ信号光は2値強度変調信号光に比べて光ファイバの 波長分散に対して大きな耐性をもつ (S. Kuwano et al., Electron. Lett., vol.31, pp.1359-1361, 1995)。 ま

はキャリア周波数成分が抑圧されているので、光ファイ パでの誘導ブリルアン散乱(以下「SBS」という。) が起こりにくく、さらに大きなパワーを光ファイバに入 射できる(米永 他、1995年信学会通信ソサイエティ大 会、B-773, 1995)。

【0006】また、波長分散による信号劣化を軽減する 手段としてプリチャープ技術がある (N. Henmi et al., IEEE J. Lightwave Technol., vol. 12, pp. 1706-1719, 1994)。これは、変調信号光にその光強度に応じた周波 数変調を施し、波長分散によりパルス圧縮を起こさせる ものである。このプリチャープは、直接変調の場合には 光源の周波数を直接変化させることにより実現でき、外 部変調の場合には2 電極駆動のMZ型光強度変調器を用 いることにより実現できる。

【0007】図13は、MZ型光強度変調器を用いた従 来の光プリチャープ伝送システムの構成例を示す。図に おいて、伝送すべき2値データ信号は2分岐され、その 一方の経路に挿入された反転回路80により反転信号と 非反転信号になり、振幅調整回路81-1,81-2お よびバイアス調整回路82を介して、それぞれMZ型光 強度変調器83の電極84-1、84-2に印加され る。電極84-1,84-2の他端には終端回路85-1,85-2が接続される。振幅調整回路81-1,8 1-2は、MZ型光強度変調器83を駆動する2つの変 調器駆動信号Vı(t), Va(t)の振幅が異なるように設定 してチャープを与える。半導体レーザ(LD) 86の出 力光は、この2つの変調器駆動信号に応じて光強度変調 され、その変調信号光が光ファイバ伝送路87に送出さ れる。光ファイバ伝送路87から出力される変調信号光 は光検波回路88で直接検波され、その検波信号を識別 器89で識別することにより2値データ信号が復調され

【0008】図14は、従来の光プリチャープ伝送シス テムにおける変調器駆動信号と変調信号光の振幅および 位相を示す。チャープの程度を表すチャープパラメータ a:は、

[0009] 【数1】

40

$$a = \frac{\frac{d \phi}{d t}}{\frac{1}{2 \, l} \cdot \frac{d \, l}{d \, t}}$$

で表される。ここで、々は光位相、「は光強度を示す。 【0010】この値は一般に光強度Ⅰに依存するので、 光強度 Ι がピークの半分のときのαをもってチャープバ ラメータと定義する。例えば、光ファイバ伝送路として 1.3 μ m 零分散ファイバを用いて1.55 μ m 帯の光信号を 伝送する場合に、負のチャープ (α<0) を与えられた 信号は、波長分散によりパルスの先端ほど遅く、尾端ほ た、このように変調して得られたデュオバイナリ信号光 50 ど速く光ファイバ中を進行するのでパルス圧縮が起こ

る。プリチャープ技術では、このパルス圧縮効果により 波長分散によって制限される伝送限界を拡大させること ができる。

【0011】図15は、従来の光伝送システムの波長分散のみによる伝送特性を示す。ここでは、「MーDD方式、プリチャープを用いた「MーDD方式、光デュオバイナリ方式における伝送距離とアイ開口劣化の関係を示す。ビットレートは10Gb/s、分散値は17ps/km/nmである。「MーDD方式は変調帯域を6GHzとし、プリチャープはチャープパラメータαを一0.8 とした。デュオパ 10イナリ信号は理想的なデュオバイナリフィルタで生成されるものとした。

【0012】図に示すように、プリチャープを用いた I M-DD方式および光デュオバイナリ方式は伝送特性の 改善がみられるが、 100 k m以上の長距離伝送では光デュオバイナリ方式が有利であることがわかる。 さらに、 長距離無中継伝送では光ファイバに大きなパワーを入射しなければならないので、 SBSの起きにくい光デュオバイナリ方式が有利と考えられる。 実際に、デュオバイナリ信号光は 1.3 μ m 零分散ファイバで 200 k m以上の 20 無中継伝送が可能であり、10 Gb/s で 210 k mの無中継伝送実験が報告されている(A. J. Price et al., IEEE P hoton. Technol. Lett., vol. 7, pp. 1219-1221, 1995)。 【0013】

【発明が解決しようとする課題】長距離の無中継伝送を行うには、光ファイバに大きな信号パワーを入射しなければならない。しかし、2値強度変調信号光は特に対策を施さない限り、SBSによるファイバ入力パワー制限を受け+10dBm程度が上限であった。また、光デュオバイナリ方式は、光ファイバに大きな信号パワーを入射す 30 ることができるが、光ファイバの非線形屈折率による自己位相変調(以下「SPM」という。)効果による信号劣化により伝送距離が制限される。

【0014】図16は、従来の光デュオバイナリ伝送システムの伝送特性を示す。10Gb/sデュオバイナリ信号光を伝送させたときに、ファイバ入力パワーが0dBmのときに比べて+14dBmのときの劣化が大きいのは、SPMによって信号スペクトルが広がったことによるものである。このようにデュオバイナリ信号光を用いても、光ファイバに大きな信号パワーを入射するとSPMによっ40て伝送距離が制限されてしまう。なお、これは送信装置と受信装置との間の光伝送路に光ファイバ増幅器や半導体光増幅器を挿入する光中維系においても同様のことが言える。

【0015】本発明は、光ファイバに大きな信号パワーを入射しても劣化が少ない変調信号光を送信できる光送信装置を提供することを目的とする。また、本発明の光送信装置を用いることにより伝送距離の長距離化、伝送速度の高速化を図ることができる光伝送システムを提供することを目的とする。

[0016]

【課題を解決するための手段】本発明の光送信装置は、 2値データ信号をデュオバイナリ信号に変換し、このデュオバイナリ信号の振幅の中央値に対する変調信号光の 強度が最小であり、デュオバイナリ信号の他の2値に対 する変調信号光の強度が最大でかつ変調信号光の位相が 互いに反転し、さらに変調信号光の位相をその強度に応 して連続的に変化させる光変調手段を用いる(請求項 1)。

6

【0017】光変調手段は、符号変換手段と、変調器駆動信号生成手段と、マッハツェンダ干渉計型光強度変調器と、光位相変調手段を用いて構成され、デュオバイナリ信号により変調された変調信号光(デュオバイナリ信号光)の位相をその強度に応じて変化させる(請求項2、3)。光位相変調手段は、マッハツェンダ干渉計型光強度変調器に与えられる一対の変調器駆動信号(デュオバイナリ信号)の振幅の中央値をシフトさせる構成でもよい(請求項4、5、6)。

【0018】光位相変調手段は、チャープを与えた変調信号光を生成し、その位相をデュオバイナリ信号の最大値と最小値に対して反転させ、チャープを与えたデュオバイナリ信号光を生成する構成でもよい(請求項7)。このように、波長分散、SBSに強いデュオバイナリ信号光がその強度に依存した位相変化(チャープ)を付与されることにより、光ファイバに大きなパワーを入射したときに制限要因となるSPMの影響を軽減することができる。

【0019】本発明の光伝送システムは、このようなデュオバイナリ信号光にチャープを与える光送信装置を用いて構成される。なお、光搬送波の波長値を光ファイバ伝送路の零分散波長値より大きく設定することにより、プリチャープの効果を高めることができる。

[0020]

【発明の実施の形態】

(光送信装置の第1の実施形態)図1は、本発明の光送信装置の第1の実施形態を示す(請求項1,2)。図において、光源となる半導体レーザ(LD)86、符号変換手段となるデュオバイナリ符号化回路70、光強度変調手段となる反転回路80,振幅調整回路81,バイアス調整回路82,MZ型光強度変調器83(電極84,終端回路85)は、図11に示す従来の光デュオバイナリ伝送システムの送信部と同様である。

【0021】本実施形態の特徴は、MZ型光強度変調器83から出力された変調信号光(デュオバイナリ信号光)の位相をその強度に応じて変化させる光位相変調手段として、MZ型光強度変調器83の出力側にチャープ付与部10を備えたところにある。チャープ付与部10は、光位相変調器11と、2値データ信号を入力して所定の遅延を与える遅延調整回路12と、その振幅を調整50して光位相変調器11を駆動する振幅調整回路13とに

より構成され、2値データ信号に比例してデュオバイナ リ信号光の位相を変調する。なお、光位相変調器11に は、LiNbOa等による電気光学効果を利用する変調 器、半導体レーザ増幅器、電界吸収型光変調器、その他 を用いることができる。

【0022】図2は、デュオバイナリ符号化回路70の 構成例を示す。(a) のデュオバイナリ符号化回路70 は、2値データ信号を差動符号化する1ビット遅延器 (T) 71および排他的論理和回路(EXOR) 72 と、その中間系列から3値のデュオバイナリ信号を生成 10 デュオバイナリ信号光の位相をその強度に応じて変化さ する1ビット遅延器(T)73および加算器74により 構成される。

【0023】(b) のデュオバイナリ符号化回路70は、 (a) の加算器 74 の出力段に低域通過フィルタ 75 を備 えた構成である。(c) のデュオバイナリ符号化回路70 は、1ビット遅延器(T)71および排他的論理和回路 (EXOR) 72と、デュオバイナリ信号生成用低域通 過フィルタ76により構成される。このフィルタの伝達 関数は、

 $H(fT) = \cos(\pi fT)$ $| fT | \leq 1/2$ H(fT) = 0|fT| > 1/2

で与えられる。ここで、fは周波数、Tは1ビット時間 幅であり、fTはビットレートで正規化した周波数を表 す。その透過率特性を図3に示す。実際には近似的にこ の特性が実現される。

【0024】デュオバイナリ信号光は"オン"と"オ フ"の2つの強度レベルをもっている。したがって、光 ファイバに大きな信号パワーで入射すると、一般的な2 値強度変調信号光と同様に、光ファイバの非線形屈折率 により発生するSPMによって信号スペクトルが過剰に 広がる。このスペクトル広がりは、波長分散による信号 劣化を増長し、伝送距離を制限する要因となる。そこ で、SPMの影響を低減するために、デュオバイナリ信 号光の位相をその光強度に応じて変調し、チャープを与 える。チャープ付与部10では、デュオバイナリ符号化 前の2値データ信号を用いて光位相変調器11を駆動 し、デュオバイナリ信号光に位相変調を与える。デュオ バイナリ信号光の"オン"と"オフ"は、変換前の2値 データ信号の"スペース"と"マーク"にそれぞれ対応 するので、デュオバイナリ信号光の強度に応じた位相変 40 調を行うことができる。このようにして生成されたチャ ープを有するデュオバイナリ信号光(以下「チャープド ・デュオバイナリ信号光」という。)が光ファイバ伝送 路に送出される。

【0025】図4は、第1の実施形態におけるチャープ 付与部10の他の構成例を示す(請求項3)。本構成で は、光カプラ14でデュオバイナリ信号光の一部を分岐 し、光検波回路15でデュオバイナリ信号光を直接検波 して光強度を検出する。光位相変調器11は、遅延調整 回路12および振幅調整回路13を介して入力されるデ 50

ュオバイナリ信号光の強度に応じて、光カプラ14を通 過したデュオバイナリ信号光の位相を変調して出力す

【0026】以上示した第1の実施形態では、MZ型光 強度変調器83から出力されたデュオバイナリ信号光が チャープ付与部10に入力されて位相変調される構成で あるが、MZ型光強度変調器83の前段にチャープ付与 部10を備え、搬送波を位相変調してMZ型光強度変調 器83に入力する構成でもよい。このような構成でも、 せたチャープド・デュオバイナリ信号光を生成すること ができる。

【0027】(光送信装置の第2の実施形態)図5は、 本発明の光送信装置の第2の実施形態を示す(請求項 1, 4, 5)。図において、光源となる半導体レーザ8 6、符号変換手段となるデュオバイナリ符号化回路7 0、光強度変調手段となる反転回路80,振幅調整回路 81, バイアス調整回路82, M2型光強度変調器83. (電極84,終端回路85)は、図1に示す第1の実施 20 形態と同様である。

【0028】本実施形態の特徴は、MZ型光強度変調器 83から出力された変調信号光の位相をその強度に応じ て変化させ、チャープド・デュオパイナリ信号光を生成 する光位相変調手段として、2値データ信号に応じてM Z型光強度変調器83の変調器駆動信号の振幅を調整す る手段を備えたところにある。その手段は、2値データ 信号の振幅を a 。 倍する振幅調整回路 2 1 と、デュオバ イナリ符号化回路70から出力されるデュオバイナリ信 号と振幅調整回路21の出力を加算する加算器22と、 反転回路80から出力される符号反転したデュオバイナ リ信号と振幅調整回路21の出力を加算する加算器23 とにより構成され、2値データ信号に比例してデュオバ イナリ信号光の位相を変調する。

【0029】図6は、第2の実施形態における変調器駆 動信号の生成過程を示す。MZ型光強度変調器83の電 極84-1に印加する変調器駆動信号1 (V₁(t)) は、 デュオバイナリ信号 (d(t)) と、振幅がα。倍された 2値データ信号 (αos(t))を加算することにより得ら れる。MZ型光強度変調器83の電極84-2に印加す る変調器駆動信号2 (V₂(t)) は、符号反転したデュオ バイナリ信号 $(\underline{d(t)})$ と、振幅が α 。倍された 2値デー 夕信号(aos(t))を加算することにより得られる。 a 。は、正負いずれかの値をとり、その符号によりチャー プの向きが決まり、その絶対値によりチャープの大きさ が決まる。なお、図5において、反転回路80と加算器 23を1つの減算器に置き替えることができる (請求項 6),

【0030】この変調器駆動信号1,2は、光デュオバ イナリ変調と同時にチャープの付与を行うために、上下 非対称の3値信号になっている。バイアス電圧は、2つ

の信号がともに中央値(最大値と最小値の中間値ではなく、図6に示すa。V/2)の時に、変調信号光の強度が最小になるように加えられる。図7は、第2の実施形態における変調器駆動信号と変調信号光の振幅および位相を示す。3値の変調器駆動信号の中央値に対する変調信号光の強度が最小であり、他の2値に対する変調信号光の強度が最大でかつ位相が互いに反転するように変調される。ここで、変調信号光の振幅は、位相反転させたものを正負の符号で表している。すなわち、正の振幅と負の振幅は互いに位相反転したものであり、光デュオバイ10ナリ変調が正しく行われていることがわかる。変調信号光の位相は、変調信号光の強度に応じて連続的に変化していることがわかる。

【0031】 (光送信装置の第3の実施形態) 図8は、本発明の光送信装置の第2の実施形態を示す (請求項 1, 7)。図において、光源となる半導体レーザ86、光強度変調手段となる反転回路80、2つの変調器駆動信号 $V_1(t)$, $V_2(t)$ の振幅が異なるように設定する振幅調整回路81-1, 81-2、バイアス回路82、MZ型光強度変調器83(電極84、終端回路85)は、図 2 20 13に示す従来の光プリチャープ伝送システムの送信部と同様である。2つの変調器駆動信号の振幅が異なることにより変調信号光にチャープが付与され、その振幅の差に応じてチャープの大きさを変化させることができる(81. Grauck et al., IEEE Photon. Technol. Lett., vo 11. 3、pp. 916-918、1991)。

【0032】本実施形態の特徴は、MZ型光強度変調器83から出力された変調信号光に対して光デュオバイナリ変調に必要な位相変化を与える光位相変調器11を備えたところにある。光位相変調器11は、デュオバイナ 30リ符号化回路70で2値データ信号から生成されたデュオバイナリ信号により駆動され、デュオバイナリ信号の最大と最小に対応する変調信号光の"オン"の光位相が互いに反転するように位相変調する。遅延調整回路12と振幅調整回路13は、デュオバイナリ信号の遅延量と振幅を調整して光位相変調器11を駆動する。本構成によっても、第1と同様のチャープド・デュオバイナリ信号光を生成することができる。

【0033】以上示した第3の実施形態では、MZ型光 強度変調器83から出力された変調信号光が光位相変調 40 器11に入力されてチャープド・デュオバイナリ信号光 に変換される構成であるが、MZ型光強度変調器83の 前段に光位相変調器11を備え、搬送波を位相変調して MZ型光強度変調器83に入力する構成でもよい。この ような構成でも、デュオバイナリ信号光の位相をその強 度に応じて変化させたチャープド・デュオバイナリ信号 光を生成することができる。

【0034】 (光伝送システムの実施形態) 図9は、本 発明の光伝送システムの実施形態を示す (請求項1

O)。図において、光送信装置31は、図1,5,8に50るMZ型光強度変調器の動作を説明する図。

10

示したような光送信装置を用いてチャープド・デュオバイナリ信号光を生成し、光ファイバ伝送路32に送出する。光受信装置33は、チャープド・デュオバイナリ信号光を光検波回路88で直接検波し、その検波信号を識別器89で識別し、反転回路90で論理反転することにより2値データ信号を復調する。

[0035]

【実施例】図10は、本発明の光伝送システムと従来の光デュオバイナリ伝送システムの伝送特性を示す。チャープド・デュオバイナリ信号光のチャープパラメータαは+1.4とした。ビットレートは10Gb/s、ファイバ入射パワーは+14dBm、ファイバ損失は0.2dB/kmである。150kmを越えるような長距離伝送においては、チャープド・デュオバイナリ信号光の方が優れており、アイ開口劣化3dBを許容できる範囲では従来のデュオバイナリ信号光に比べて伝送距離を約50km延ばすことができる。

[0036]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の光送信装置およびそれを用いた光伝送システムは、チャープド・デュオバイナリ信号光を生成することによりSPMによる劣化が軽減される。したがって、1.3零分散ファイバのように比較的分散値の大きな光ファイバを伝送路として用いる光伝送系において、伝送距離の長距離化および伝送速度の高速化を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光送信装置の第1の実施形態を示すブロック図。

【図2】デュオバイナリ符号化回路70の構成例を示す ブロック図。

【図3】デュオバイナリ信号生成用低域通過フィルタ7 6の誘過率特性を示す図。

【図4】第1の実施形態におけるチャープ付与部10の 他の構成例を示すブロック図。

【図5】本発明の光送信装置の第2の実施形態を示すブロック図。

【図6】第2の実施形態における変調器駆動信号の生成 過程を説明する図。

【図7】第2の実施形態における変調器駆動信号と変調信号光の振幅および位相を示す図。

【図8】本発明の光送信装置の第3の実施形態を示すブロック図。

【図9】本発明の光伝送システムの構成例を示すブロッ ク図

【図10】本発明の光伝送システムと従来の光デュオバイナリ伝送システムの伝送特性を示す図。

【図11】従来の光デュオバイナリ伝送システムの構成 例を示す図。

【図12】従来の光デュオバイナリ伝送システムにおけるM2型光強度変調器の動作を説明する図。

11

【図13】M2型光強度変調器を用いた従来の光プリチャープ伝送システムの構成例を示す図。

【図14】従来の光プリチャープ伝送システムにおける 変調器駆動信号と変調信号光の振幅および位相を示す 図。

【図15】従来の光伝送システムの波長分散のみによる 伝送特性を示す図。

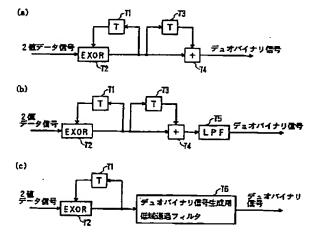
【図16】従来の光デュオバイナリ伝送システムの伝送 特性を示す図。

【符号の説明】

- 10 チャープ付与部
- 11 光位相変調器
- 12 遅延調整回路
- 13,21 振幅調整回路
- 14 光カプラ
- 15 光検波回路
- 16, 75 低域通過フィルタ (LPF)
- 22, 23 加算器

【図2】

デュオバイナリ符号化回路70の構成機



[図9]

31 光送信装置

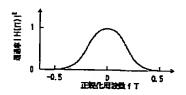
- 32,87 光ファイバ伝送路
- 33 光受信装置
- 70 デュオバイナリ符号化回路
- 71, 73 1ビット遅延器 (T)
- 72 排他的論理和回路(EXOR)
- 7.4 加算器
- 76 デュオバイナリ信号生成用低域通過フィルタ

12

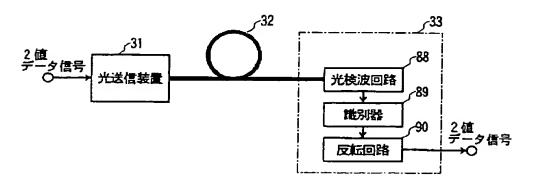
- 80 反転回路
- 10 81 振幅調整回路
 - 82 バイアス調整回路
 - 83 MZ型光強度変調器
 - 84 電極
 - 85 終端回路
 - 86 半導体レーザ (LD)
 - 88 光検波回路
 - 89 織別器
 - 90 反転回路

【図3】

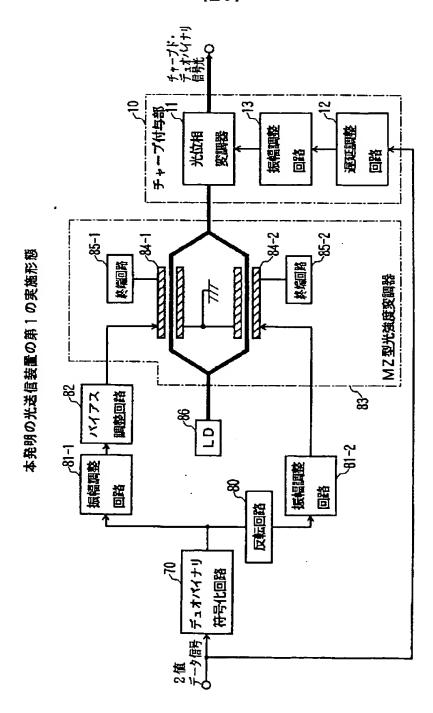
デュオバイナリ信号生成用低过速道フィルタ78の迅速率特性



本発明の光伝送システムの実施形態

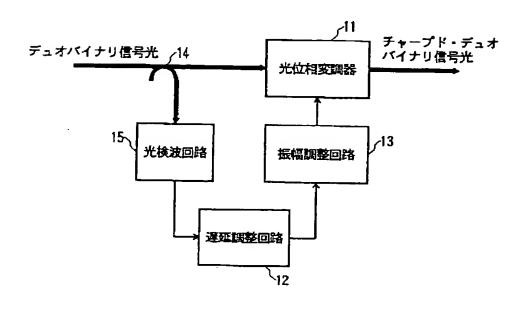


[図1]



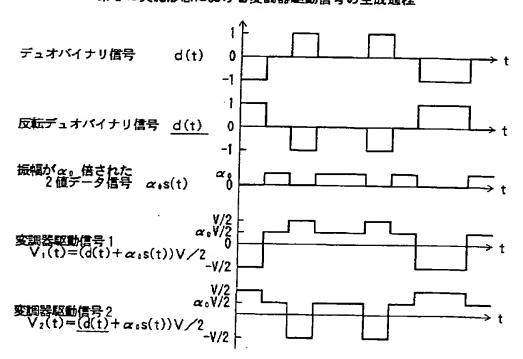
[図4]

第1の実施形態におけるチャープ付与部10の他の構成例

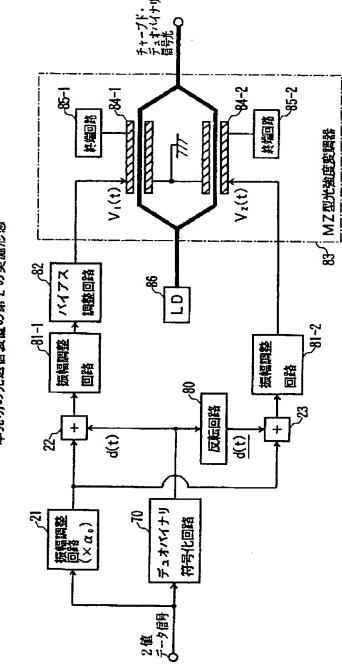


【図6】

第2の実施形態における変調器駆動信号の生成過程



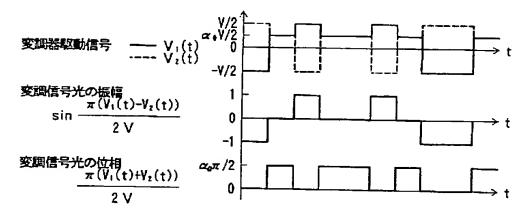
[図5]



本発明の光送信装置の第2の実施形態

[図7]

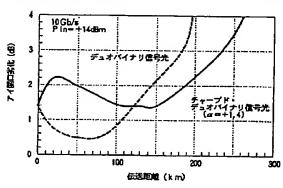
第2の実施形態における変調器駆動信号と変調信号光の振幅および位相



【図10】

【図12】

本発明の先伝送システムと従来の光デュオバイナリ伝送システムの伝送特性



従来の先デュオバイナリ伝送システムにおけるMZ型先達度変質器の動作

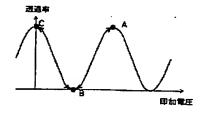
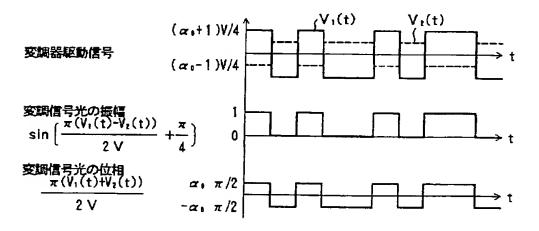
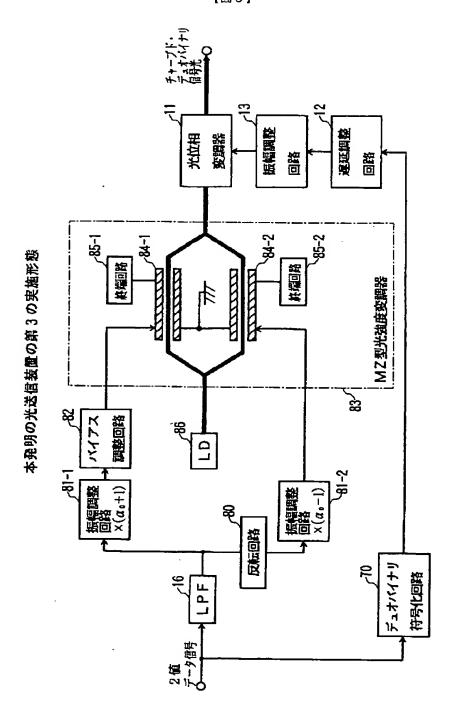


図14]

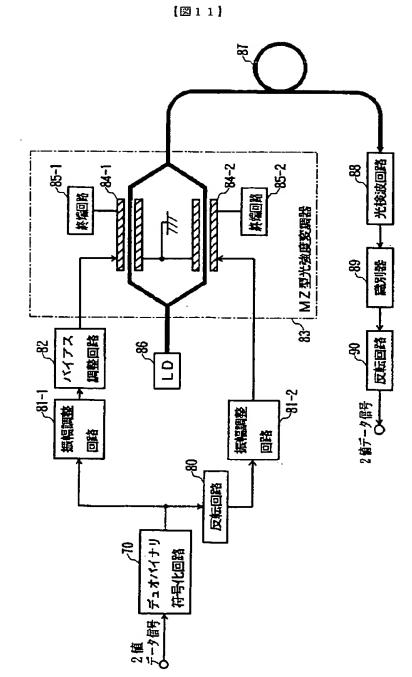
従来の光ブリチャープ伝送システムにおける 変調器駆動信号と変調信号光の振幅および位相



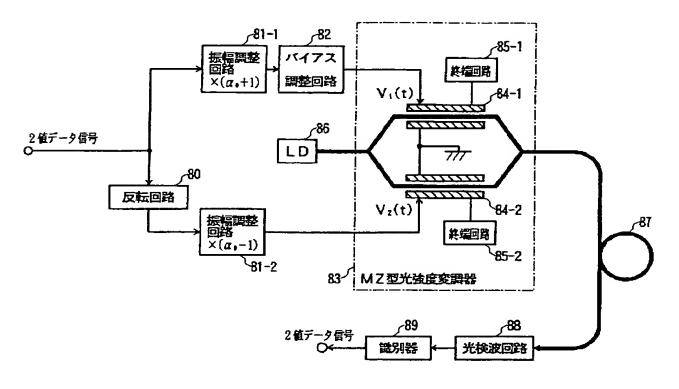
[図8]



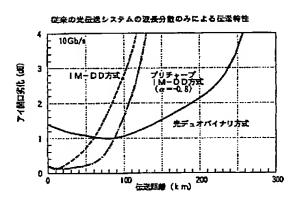
従来の光デュオバイナリ伝送システムの構成例



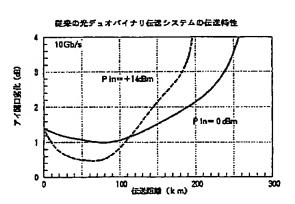
【図13】 MZ型光強度変調器を用いた従来の光プリチャープ伝送システムの構成例



[図15]



【図16】



フロントページの続き

H O 4 B 10/06 10/28 10/26

10/14

(51) Int. Cl. 6

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

JAPANESE PATENT GAZETTE (A)

(11) Publication Number: Hei 08-076071

(43) Date of Publication of Application: March 22, 1996

(51) Int. Cl.⁶ G02F 1/03 H03F 1/34

(21) Application Number: 06-209803 (22) Date of Filing: September 2, 1994

(71) Applicant: OKI ELECTRIC COMPANY LTD.

(72) Inventors: Naomi, OHASHI

Bunha, OU

Yukihiro, OZEKI

(54) Title of the Invention: BLAS VOLTAGE CONTROL CIRCUIT FOR EXTERNAL OPTICAL MODULATOR

[0011]

Next, the operation shown in Fig. 1 will be described. Incident light Pi is inputted to the optical coupler 71 and branched into incident light Piland incident light Pi2. The incident light Pi1 is inputted to the LN modulator 10 and converted for output into a current il that is in proportion to the power of output light Po, similarly to the prior art. Meanwhile, the incident light Pi2 is converted into a current i2 that is in proportion to the power of the incident light P1 and outputted from the PD72. By inputting these two currents i1 and i2 to the divider 80, output voltage that is in proportion to the average power transmission rate of the LN modulator 10 is obtainable at the output terminal of the divider 80. With an increase in the output voltage the negative feedback circuit biases the modulation voltage Vm of the LN modulator 10 to reduce the output voltage. Also, with a decrease in the output voltage the negative feedback circuit 40 biases the modulation voltage Vm of the LN modulator 10 to increase the output voltage. That is, the negative feedback circuit 40 biases the modulation voltage Vm of the LN modulator 10 in such a manner that the average power transmission rate is to be a fixed value which is determined by the variable reference voltage source 42. [0012]

As described above, the present embodiment enables a stable control of the bias voltage of the LN modulator 10 without being affected by fluctuation in the power of the incident light of the LN modulator 10 or by direct-current light or incident light pulses of the incident light signal because the bias voltage control is made not by measuring the average output light level of the LN modulator 10 but by measuring the optical power transmission rate thereof to maintain it constant. Note that the present embodiment has described the optical transmission apparatus of 10Gb/s as a way of example; however, the invention is used for drift compensation technique for optical signal processing circuit using a common LN modulator which operates irreverent of frequency.